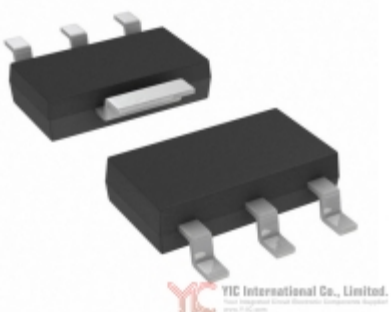

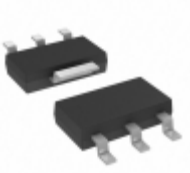

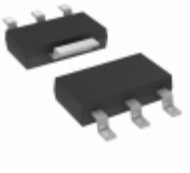


	<h2 style="color: red;">FDT86113LZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDT86113LZ</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p> <p>Datenblätter: 1.FDT86113LZ.pdf 2.FDT86113LZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 127381 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDT86113LZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	127381 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	25 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 3.3A (Tc) 2.2W (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 3.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	315pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDT86113LZ-ND

FDT86113LZ ist neu im Original, Suche FDT86113LZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT86113LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDT86113LZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDT86246 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p>FDT86106LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4</p>	 <p>FDT86106LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4</p>	 <p>FDT86244 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p>
 <p>FDT86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.6A SOT-223</p>	 <p>FDT86244 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p>	 <p>FDT86113LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p>	 <p>FDT86102LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.6A SOT-223</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ 1812GC102MAT1A	➡ 744324220	➡ AT24C04N-SU2.7	D BSR188FSC	➡ CC0805JRNPO0BN120
⚡ FAN2518S28X_NL	⚙ FDT1600N10ALZ	D FDT1600N10ALZ	➡ FDT3N40TF	➡ FDT3N40TF
⚙ FDT434P-NL	⚡ FDT439N-NL	⚙ FDT458P-NL	➡ FDT55AN06LA0	➡ FDT55AN06LA0
D FDT86102LZ	⚙ FDT86102LZ	⚡ FDT86106LZ	⚙ FDT86106LZ	➡ FDT86113LZ
➡ FDT86244	➡ FDT86244	⚙ FDT86246	⚡ FDT86246	➡ FDT86246L
➡ FDT86246L	➡ FDT86256	D FDT86256	⚙ GCU40AB-90	⚡ GRM1885C2A7R4CA01D
⚙ GRT31CR61C106ME01L	D INA203AIDGSR	➡ IPP100N04S4-H2	➡ LT1172CS8#TRPBF	➡ M1N1HRM1721
⚡ MMBT2222AW	⚙ P270C2101	➡ QM08N60F	➡ RS3JB-13	➡ SIHD7N60E-GE3
⚙ SKFH150/08DS	⚡ SML4741A	⚙ SSRD-240D40	D STM32P103T8ABC	➡ TC160G54AF-1225
➡ TL2575-33IKTTR	⚙ TM55RZ-H	⚡ TT131N1100KOC	⚙ UCC27201DRM	➡ UPD75P008CU

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

